

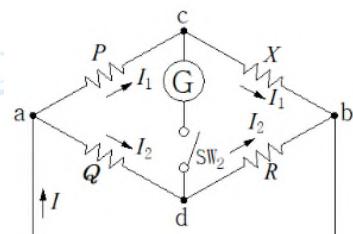
## 전기 이론

동영상 바로보기 (전병렬 버전)		동영상 바로보기 (송건웅 버전)	
-------------------------	--	-------------------------	--

- 전기에너지 : 전기의 발생은 전자의 이동으로 발생
- ▶ 자유전자(free electron)의 이동
- 대전 : 어떤 물체가 전기를 띠는 현상
- ▶ 마찰대전 : 두 물체 사이의 마찰로 발생
- ▶ 박리대전 : 서로 밀착된 물체가 떨어질 때 발생
- ▶ 유동대전 : 액체류가 파이프 등 내부에서 유동할 때 발생
- ▶ 기타대전 : 분출대전, 충돌대전, 진동(교반)대전, 유도대전 등
- (-)대전상태 : 물질 중의 자유전자가 과잉된 상태
- 전기량의 기호 : Q, 단위 : 쿠лон(coulomb, 기호[C])
- 1eV(전자볼트) :  $1.602 \times 10^{-19}$  [J]
- 전자의 질량 :  $9.10956 \times 10^{-31}$  [kg]
- 전자의 흐름 : 음(-)극에서 양(+)극으로, 전류의 흐름은 반대
- 전류, 전기량, 시간의 관계  $I = \frac{Q}{t}$  [A],  $Q = It$  [C]
- 전압, 일, 전기량의 관계 :  $V = \frac{W}{Q}$  [V],  $W = Q \cdot V$  [J]
- 기전력 : 전위차를 만들어주는 힘
- 기자력 : 자속을 계속 흐르게 하는 힘
- 저항 :  $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$  [\Omega], 고유저항의 단위 [\Omega·m]
- ▶ 도체의 저항은 고유저항에 비례하고 단면적에 반비례
- 저항에 영향을 주는 변수 : 종류, 고유저항, 길이, 단면적
- 저항률이 낮은 재료 : 은 > 구리 > 금 > 알루미늄
- 금속도체 : 온도 상승  $\Rightarrow$  전기저항이 증가
- 도전율(전도율) : 저항률의 역수,  $\sigma = \frac{1}{\rho}$ , 기호  $\sigma$ , 단위 [ $\Omega/m$ ]
- $1[\Omega \cdot m] = 10^2 [\Omega \cdot cm] = 10^6 [\Omega \cdot mm^2/m]$
- 컨덕턴스(어드미턴스의 실수부) :  $G = \frac{1}{R}$  [ $\Omega$ ]
- 어드미턴스(임피던스의 역수) :  $Y = \frac{1}{Z}$  [ $\Omega$ ]
- 옴의 법칙 : 전압, 전류, 저항의 관계  $I = \frac{V}{R}$  [A]
- 저항의 접속
- ▶ 직렬 합성저항 :  $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$  [\Omega]

- ▶ 병렬 합성저항 :  $R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$  [\Omega]
- ▶ 두 개 합성저항 :  $R_p = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$  =  $\frac{\text{두 저항의 곱}}{\text{두 저항의 합}}$
- ▶ 세 개 합성저항 :  $R_p = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$  =  $\frac{\text{세 개 곱}}{\text{두 개씩 합}}$

- 저항에 걸리는 전압은 저항의 크기에 비례한다.
- 키르히호프의 1법칙(전류법칙), 제 2법칙(전압법칙)
- 전지 n개 직렬 접속할 때 전류 :  $I = \frac{nE}{nr+R}$  [A]
- 각종 단위 : 투자율[H/m], 유전율[F/m], 자장의세기[AT/m], 전장의세기[V/m], 자기저항[AT/Wb], 전속밀도[C/m<sup>2</sup>], 자속밀도[Wb/m<sup>2</sup>]
- 전력(electric power) :  $P = \frac{W[J]}{t[\text{sec}]}$  [W]
- $P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = I^2 R$  [W] : 전력은 전압의 제곱에 비례
- 최대전력전달 : ‘내부저항 = 외부저항’ 일 때
- 1HP(마력) : 746W
- 전력량 : 어느 일정 시간 동안 전기에너지가 한 일의 양
- $W=Pt$  [J],  $[W \cdot \text{sec}] / 1[W \cdot \text{sec}] = 1[J]$
- $1[kWh] = 10^3[W \cdot h] = 10^3 \times 3600[W \cdot \text{sec}] = 3.6 \times 10^6[J]$
- ▶ 전기의 발열작용 : 다리미, 백열전구, 고주파가열기, 전자레인지
- 줄의 법칙 : 전류가 흐르면 열이 발생  $H = 0.24I^2Rt$  [cal]
- 전열기 용량 :  $860Pt\eta = McT$
- 종합의 정리 해석할 때 : 전압원(단락), 전류원(개방)
- 측정할 때 : 전압계(병렬접속), 전류계(직렬접속)
- 배율기 : 전압계의 측정 범위를 넓힘(전압계와 직렬접속)
- 분류기 : 전류계의 측정 범위를 넓힘(전류계와 병렬접속)



- 휘트스톤 브리지 평형 :  $PR = QX$ ,  $X = \frac{P}{Q}R$
- 묽은황산+구리+아연  $\Rightarrow$  구리판 + 수소기체발생
- 구리의 전기분해 : 음극(두꺼워짐), 양극(얇아짐)
- 납축전지의 전해액 : 황산( $H_2SO_4$ ), 양극재료 :  $PbO_2$
- 망간건전지 : 양극(탄소막대), 음극(아연원통), 전해액(염화암 모늄 용액)

- 패러데이의 법칙 : 전기분해로 석출되는 물질의 양은 전해액을 통과한 총 전기량에 비례한다.
- 석출량 :  $W = KQ = KIt [g]$
- 화학당량 = 원자량/원자가
- 분극작용 : 원인(수소기체), 해결법(감극제 사용)
- 국부작용 : 원인(전극의 불순물), 해결법(수은도금)
- 축전지의 용량 :  $Ah(\text{전류} \times \text{시간})$
- 1차전지 : 충전이 불가(망간·산화은·수은전지)
- 2차전지 : 재충전이 가능(니켈-카드뮴·납·알カリ전지)
- 전지의 용량 :  $n$ 개 직렬  $\Leftrightarrow$  1개 용량값,  $n$ 개 병렬  $\Leftrightarrow$   $n$ 개 용량값
- 허용전류 : 안전하게 흘릴 수 있는 최대전류
- 보호소자 : 바리스터(이상전압에 대한 회로보호), 서미스터(온도)
- 제벡효과 : 다른 온도  $\Leftrightarrow$  기전력 발생(열전 온도계)
- 펠티어효과 : 전류를 흘리면  $\Leftrightarrow$  열의 발생 또는 흡수(전자냉장고)
- 톰슨효과 : 도체 막대기의 양 끝을 다른 온도로 유지하고 전류를 흘릴 때 발열 또는 흡열이 일어나는 현상
- 정전 유도(electrostatic induction) : 도체에 대전체를 접근시키면 대전체에 가까운 쪽에서는 대전체와 다른 전하가 나타나며 그 반대쪽에는 대전체와 같은 종류의 전하가 나타나는 현상
- 강자성체 : 비투자율  $\mu_s \gg 1$ , 자화율  $\chi \gg 0$ , 정전자폐
- ▶ 철, 니켈, 코발트, 망간
- 상자성체 : 비투자율  $\mu_s > 1$ , 자화율  $\chi > 0$ ,
- ▶ 알루미늄, 백금, 주석, 산소, 질소
- 반(역)자성체 : 비투자율  $\mu_s < 1$ , 자화율  $\chi < 0$ . 자석에 반발
- ▶ 비스무트, 은, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연
- 비자성체 : 자화가 되지 않아 자기장에 반응안함
- 쿨롱의 법칙 :  $F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N]$
- 유전율 :  $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_s [F/m]$
- 진공 중 정전기력 :  $F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N]$
- 전기력선 특징
  - ① 양전하(+)에서 음전하(−)로 이동
  - ② 두 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
  - ③ 전기력선은 등전위면과 직교한다.
  - ④ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입, 도체 내부에는 없다.
- 패러데이관의 단위 전위차당 보유에너지 :  $\frac{1}{2} [J]$
- 전기량(전하량) :  $Q=CV$ ,  $C$  : 비례상수
- 평판 커패시터의 정전용량 :  $C = \frac{Q}{V} = \epsilon \frac{S}{d} [F]$
- ▶ 커패시터 정전용량은 유전율과 극판면적에 비례, 간격에 반비례
- 접두어 :  $1\mu F = 10^{-6} F$ ,  $1nF = 10^{-9} F$ ,  $1pF = 10^{-12} F$

- 전속밀도 :  $D = \frac{Q}{S} [C/m^2]$ ,  $D = \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_s E [C/m^2]$
- 전위 :  $V = Er [V]$ ,  $V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q}{r} [V]$
- 전해 콘덴서 : 극성이 있어 직류 회로에 사용
- 탄탈 콘덴서 : 극성이 있고, 몰드수지로 봉합, 주파수 높은 회로에 사용
- 세라믹 콘덴서 : 티탄산바륨사용, 가성비, 유전율 크고 극성없음
- 바리콘 : 가변용량 콘덴서(용량을 변화시킬 수 있음)
- 커패시터(콘덴서)의 접속
  - ▶ 직렬접속 :  $C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} [F]$
  - ▶ 2개의 직렬접속 :  $C = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} [F]$
  - ▶ 병렬접속 :  $C = C_1 + C_2 + C_3 [F]$
- 정전흡인력 :  $W = \frac{1}{2} \epsilon E^2 [N/m^2]$ (전압의 제곱에 비례)
- 자력선은 N극(정자극)에서  $\Leftrightarrow$  S극(부자극)으로 간다.

## [ 자기회로와 전기회로의 대응관계 ]

자기회로	전기회로
기자력 $F = NI = R\phi [AT]$	기전력 $E = IR [V]$
자속 $\phi = \frac{F}{R} [Wb]$	전류 $I = \frac{E}{R} [A]$
자기저항 $R = \frac{l}{\mu S} [AT/Wb]$	전기저항 $R = \rho \frac{1}{S} = \frac{1}{kS} [\Omega]$
투자율 $\mu [H/m]$	도전율 $k [U/m]$
자속밀도 $B = \frac{\phi}{S} [Wb/m^2]$	전류밀도 $J = \frac{I}{S} [A/m^2]$
자기력선의 총 수 $\frac{m}{\mu} \text{ 개}$	전기력선의 총 수 $\frac{Q}{\epsilon} \text{ 개}$

- 자석의 쿨롱의 법칙 :  $F = \frac{1}{4\pi\mu} \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2} [N]$
- 자기장  $H$ ,  $m$ 의 자하, 힘의 관계 :  $F = mH [N]$
- 자속 밀도, 자기장의 세기 :  $B = \mu H = \mu_0 \mu_s H [Wb/m^2]$
- 토크 :  $T = MH \sin\theta [N \cdot m]$
- 자기모멘트 :  $M=mI$
- 전자력 크기 :  $F = B I l \sin\theta [N]$
- 양페르의 오른나사의 법칙 : 전류와 자장의 방향
- 비오-사바르의 법칙 :  $\Delta H = \frac{I \Delta l}{4\pi r^2} \sin\theta [AT/m]$
- $1T(\text{테슬라}) = 1Wb/m^2 = 10000G(\text{가우스})$

## [자기장의 세기]

무한장 직선	$H = \frac{I}{2\pi r} [\text{AT/m}]$
환상 솔레노이드	$H = \frac{NI}{2\pi r} [\text{AT/m}]$
원형코일	$H = \frac{NI}{2r} [\text{AT/m}]$

- 평행 도체 사이에 작용하는 힘 :  $F = \frac{2 I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} [\text{N/m}]$
  - ▶ 같은 방향 : 흡인력, 다른 방향 : 반발력
  - 패러데이의 전자유도 법칙 :  $e = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} [\text{V}]$
  - 렌츠의 법칙 : 자속의 증감을 ‘방해’하는 방향으로 발생
  - 자체 인덕턴스 :  $L = \frac{N\Phi}{I} [\text{H}]$
  - 코일의 합성인덕턴스 :  $L = L_1 + L_2 \pm 2M$
  - ▶ 가동접속( $L_1 + L_2 + 2M$ ), 차동접속( $L_1 + L_2 - 2M$ )
  - 결합계수 :  $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ ,  $k=1$ 일 때  $M = \sqrt{L_1 L_2}$
  - 상호 인덕턴스 :  $M = k\sqrt{L_1 L_2} [\text{H}]$
  - 코일에 축적되는 에너지 :  $W = \frac{1}{2} L I^2 [\text{J}]$
  - 커패시터에 축적되는 에너지 :  $W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 [\text{J}]$
  - 각속도 :  $\omega = 2\pi f [\text{rad/sec}]$
  - 주기(period) : 1사이클의 변화에 필요한 시간
  - 주파수(frequency) : 1초 동안에 반복되는 사이클의 수
  - 실측값 V와 최댓값  $V_m$ 의 관계
- $$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 V_m, V_m = \sqrt{2} \times V = 1.414 \times V$$
- 평균값  $V_a$ 와 최댓값  $V_m$ 의 관계
- $$V_a = \frac{2}{\pi} V_m = 0.637 V_m [\text{V}]$$



- 복소수
  - 모양 : 실수부 + 허수부
  - 절댓값 :  $Z = \sqrt{(\text{실수부})^2 + (\text{허수부})^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$
  - RLC 직렬회로

## [RLC 직렬회로]

	R만의 회로	L만의 회로	C만의 회로
위상	동상	지상회로 (전류가 뒤짐)	진상회로 (전류가 앞섬)
임피던스	$Z=R[\Omega]$	$X_L = \omega L = 2\pi f L$ 유도리액턴스 [ $\Omega$ ]	$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$ 용량리액턴스 [ $\Omega$ ]
전류	$I = \frac{V}{R} [\text{A}]$	$I = \frac{V}{\omega L} [\text{A}]$	$I = \omega CV = \frac{V}{\frac{1}{\omega C}} [\text{A}]$

- RLC 직렬 합성 임피던스 :  $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} [\Omega]$

## [공진현상]

	직렬회로	병렬회로
최소	$Z(\text{임피던스})$	$I(\text{전류})$
최대	$I(\text{전류})$	$Z(\text{임피던스})$

- 공진 :  $X_L = X_C$
- 공진주파수 :  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} [\text{Hz}]$
- 피상전력 :  $P_a = VI [\text{VA}], P_a = \sqrt{P^2 + P_r^2} [\text{VA}]$
- 유효전력 :  $P = VI \cos\theta [\text{W}]$
- 무효전력 :  $P_r = VI \sin\theta [\text{Var}]$
- 역률 :  $P = \frac{\text{유효전력}}{\text{피상전력}} = \frac{VI \cos\theta}{VI} = \cos\theta$
- 전력용 콘덴서 : 부하와 병렬로 결선하여 역률을 개선
- RLC직렬회로의 역률 :  $\cos\theta = \frac{R}{Z}$

## [Y-△ 결선]

	Y결선	△결선
모양		
전압	선간전압 = $\sqrt{3} \times \text{상전압}$	선간전압 = 상전압
전류	선전류 = 상전류	선전류 = $\sqrt{3} \times \text{상전류}$
위상	선간전압이 $30^\circ$ 앞섬	선전류가 $30^\circ$ 뒤짐

- Y-△ 등가 임피던스 변환 :  $\dot{Z}_\Delta = 3 \dot{Z}_Y [\Omega]$
- 소비전력
- 단상 :  $P = VI \cos\theta [\text{W}]$
- 3상 :  $P = \sqrt{3} VI \cos\theta [\text{W}]$
- 3상에서 각상의 합성소비전력 :  $P = P_a + P_b + P_c$
- 2전력계법 소비전력 :  $P = P_1 + P_2$

# 요점정리 2025 전기기능사 필기

- 비사인파구성 = 직류분 + 기본파 + 고조파 (푸리에 분석)
- 비사인파의 실효값 :  $\sqrt{V_0^2 + V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2}$
- 비사인파 발생원인 : 자기포화, 히스테리시스, 전기자반작용
- 각 고조파의 실효값의 제곱의 합의 제곱근
- 왜형율 ( $\epsilon$ ) =  $\frac{\text{전고조파의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}}$
- 파형률 =  $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$ , 파고율 =  $\frac{\text{최댓값}}{\text{실효값}}$ ,
- 구형파 : 무수히 많은 주파수의 합성, 파형률과 파고율 = 1
- 정상상태 : 전류가 일정한 값에 도달한 상태
- 과도상태 : 정상상태에 도달하기 전의 상태